



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN	xii
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
I.1. Latar Belakang	2
I.2. Perumusan Masalah	4
I.2.1. Batasan Masalah	4
I.3. Tujuan Penelitian	4
I.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III DASAR TEORI	9
III.1. Silikon Karbida (SiC).....	9
III.1.1. Struktur Kristal.....	9
III.1.2. Sifat-Sifat Elektrikal	12
III.2. Dioda Penghalang Schottky	15
III.2.1. Teori Kontak Schottky	18
III.2.2. Efek-Efek Nonideal pada Penghalang Schottky	21
III.2.3. Hubungan Arus-Tegangan	25
BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN	29
IV.1. Alat dan Bahan Penelitian.....	29
IV.2. Tata Laksana Penelitian	31
IV.3. Rencana Analisis Hasil Penelitian	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
V.1. Hasil Penelitian	50
V.1.1. Analisis Hasil Pengujian Arus-Tegangan	50





V.1.2. Hasil Perhitungan Berbagai Parameter Dioda Schottky	53
V.1.3. Kurva I-V kontak Schottky yang Menunjukkan Perilaku <i>Tunneling</i> . .	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	66
VI.1. Kesimpulan	66
VI.2. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74

